

روابط کوانتومی ورودی - خروجی تیغه مغناطودیالکتریک متحرک

احسان عموقربان^{۱،۲}، علی مهدی فر^۱ و مرضیه حسینزاده^۱

^۱ دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم، گروه فیزیک

^۲ دانشگاه شهرکرد، گروه پژوهشی فوتونیک

چکیده - در این مقاله با استفاده از رهیافت پدیده شناختی در کوانتاش میدان الکترومغناطیسی در حضور محیطهای مغناطودیالکتریک متحرک، روابط کوانتومی ورودی - خروجی را برای تابشهای فرودی عمود بر تیغه مغناطودیالکتریکی که به موازات سطح حرکت می کند بدست می آوریم.

کلید واژه - محیط مغناطودیالکتریک متحرک، کوانتاش میدان الکترومغناطیسی، روابط کوانتومی ورودی - خروجی

Quantum input-output relations for a magnetodielectric moving slab

Ehsan Amooghorbani^{1,2}, Ali Mahdifar^{1,2}, and Marzye Hoseinzadeh¹

¹ Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University

² Photonics Research Group, Shahrekord University

Abstract- In this paper, by using the phenomenological approach in quantization of the electromagnetic field in the presence of moving magnetodielectric media, we obtain the quantum input-output relations for perpendicular incident radiations to a magnetodielectric slab which is moving parallel to its surface.

Keywords: Moving magnetodielectric media, electromagnetic field quantization, quantum input-output relations.

الکترومغناطیسی فرودی بر آن بررسی کردند [۴]. اخیراً الکترومغناطیسیک محیطهای متحرک نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. محیطهای مزبور از یک طرف یک منبع بالقوه برای تولید مواد با ضریب شکست منفی هستند [۵] و از طرف دیگر همانند یک میدان گرانشی موثر رفتار می کنند [۶]. به عبارت دیگر الکترومغناطیسیک محیطهای متحرک مشابه اپتیکی پدیدههای نجومی را در آزمایشگاه فراهم می کنند. تاکنون مسئله اثر حرکت محیط بر امواج الکترومغناطیسی بیشتر به صورت کلاسیکی بررسی شده است. به منظور بررسی اثرات کوانتومی محیط متحرک بر انتشار امواج الکترومغناطیسی لازم است ابتدا کوانتاش امواج الکترومغناطیسی در حضور محیط متحرک انجام شود. تاکنون دو روش پدیده شناختی و لاگرانژی برای کوانتاش امواج الکترومغناطیسی در حضور محیطهای

۱- مقدمه

در الکترومغناطیسیک کلاسیک مطالعات متعددی در رابطه با اثر حرکت محیط بر انتشار امواج انجام شده است. مینکوفسکی در سال ۱۹۰۸ به مطالعه امواج الکترومغناطیسی در حضور محیطهای متحرک پرداخت و معادلات ساختمندی که به معادلات مینکوفسکی معروف هستند را از دید ناظر در چارچوب آزمایشگاه بدست آورد [۱]. پائولی و سامرفیلد تغییر بسامد موج بازتاب شده از محیط نامتناهی متحرک را محاسبه کردند [۲ و ۳]. شیوزاوا و همکارانش تیغه ای که در دو وضعیت عمود و موازی با سطح خارجی اش حرکت می کند را در نظر گرفتند و اثر پراکندگی محیط متحرک را بر موج

می‌آید. اکنون با معرفی این تانسورهای موثر می‌توان کوانتش میدان‌های الکترومغناطیس در حضور محیط‌های متحرک را مشابه محیط‌های ساکن انجام داد. بر این اساس، بردارهای قطبش نوفه و مغناطش نوفه که وابسته به ویژگی‌های اتلافی محیط هستند را به صورت دستی به معادلات ساختمندی جدید اضافه می‌کنیم. سپس با استفاده از پیمانه‌ی کولن، معادله موج را برحسب پتانسیل برداری و تانسورهای موثر محیط بدست می‌آوریم. پاسخ معادله‌ی موج بر حسب تانسور گرین به صورت زیر بیان می‌شود

(۲) $\hat{\mathbf{A}}(z, \omega) = -\mu_0 \int dz' \mathbf{G}(z, z', \omega) \cdot \hat{\mathbf{J}}_N(z', \omega)$.
 در این جا، چگالی جریان $\hat{\mathbf{J}}_N(z, \omega)$ به صورت تابعی از میدان‌های بوزونی $\hat{\mathbf{f}}_e(z, \omega)$ و $\hat{\mathbf{f}}_m(z, \omega)$ که بیانگر برانگیختگی‌های میدان الکترومغناطیسی و ماده هستند به شکل زیر تعریف می‌شوند

$$\hat{\mathbf{J}}_N(z, \omega) = \omega \sqrt{\frac{\hbar \epsilon_0}{\pi S}} \bar{\bar{\epsilon}}_{eff}^{-1}(\omega) \cdot \hat{\mathbf{f}}_e(z, \omega) + \nabla \times \sqrt{\frac{-\hbar}{\pi \mu_0 S}} \bar{\bar{\kappa}}_{eff}^{-1}(\omega) \cdot \hat{\mathbf{f}}_m(z, \omega), \quad (۳)$$

که در آن $\bar{\bar{\kappa}}_{eff}^{-1}(\omega) = \bar{\bar{\mu}}_{eff}^{-1}(\omega)$ بوده و S بیانگر مساحت ناحیه‌ی کوانتش در صفحه‌ی عمود بر انتشار است. در اینجا فرض می‌کنیم امواج الکترومغناطیسی با دو قطبش خطی عمود بر هم و در جهت محور z ها منتشر می‌شوند. با انجام محاسبات طولانی تانسور گرین محیط متحرک نامتناهی به صورت زیر بدست می‌آید

$$\frac{\mathbf{G}(z, z', \omega)}{e^{ik|z-z'|}} = \begin{pmatrix} \frac{-i\mu}{2k} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-i\mu_{eff,xx}}{2k} & \frac{im}{2\alpha\epsilon\omega/c} \\ 0 & \frac{im}{2\alpha\epsilon\omega/c} & \frac{i(k-n^2\alpha^2)}{2\alpha\epsilon k} \end{pmatrix} \quad (۴)$$

که در آن $k = n\omega/c = \sqrt{\frac{\alpha^2 n^2 - m^2}{\alpha}} \omega/c$ است.

اکنون با جایگذاری روابط (۳) و (۴) در رابطه‌ی (۲) مولفه‌های پتانسیل برداری به صوت زیر بدست می‌آیند

متحرک ارائه شده است [۷-۸]. با توجه به این که اثرات پراکندگی ناشی از محیط متحرک بر حالت‌های کوانتومی فرودی را می‌توان برحسب روابط ورودی-خروجی بیان کرد، از این رو در این مقاله، با استفاده از رهیافت پدیده‌شناختی روابط کوانتومی ورودی-خروجی را برای تیغه مغناطودی‌الکتریکی که در راستای سطح بیرونی‌اش حرکت می‌کند را بدست می‌آوریم.

۲- روابط پایه

در این بخش به بررسی کوانتش میدان الکترومغناطیسی به روش پدیده‌شناختی در حضور یک محیط مغناطودی‌الکتریک متحرک نامتناهی می‌پردازیم. به منظور ساده‌سازی محاسبات، یک محیط غیرجاذب، همگن و همسانگرد در نظر می‌گیریم که با سرعت یکنواخت $\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{y}}$ نسبت به چارچوب آزمایشگاه و عمود بر راستای انتشار امواج الکترومغناطیس در حال حرکت است. در این جا چارچوب ساکن نسبت به محیط را به صورت چارچوب متحرک تعریف می‌کنیم. معادلات ماکسول حاکم بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در چارچوب آزمایشگاه و چارچوب متحرک شکل ریاضی مشابهی دارند ولی در روابط ساختمندی متفاوتی صدق می‌کنند [۹]. در مرجع [۷] با بهرگیری از روابط ساختمندی مینکوفسکی و معرفی تانسور گذردهی الکتریکی موثر $\bar{\bar{\epsilon}}_{eff}$ و تانسور تراوایی مغناطیسی موثر $\bar{\bar{\mu}}_{eff}$ نشان داده شده است که بردارهای میدان الکتریکی و مغناطیسی به ترتیب در چارچوب آزمایشگاه در روابط ساختمندی جدید $\mathbf{D} = \epsilon_0 \bar{\bar{\epsilon}}_{eff} \cdot \mathbf{E}$ و $\mathbf{B} = \mu_0 \bar{\bar{\mu}}_{eff} \cdot \mathbf{H}$ صدق می‌کنند. مشاهده می‌کنیم که این روابط شکل ریاضی مشابهی با روابط ساختمندی در چارچوب متحرک دارند ولی اگر محیط متحرک همگن و همسانگرد و غیرمغناطیسی باشد از دید ناظر آزمایشگاه ناهمگن، ناهمسانگرد و مغناطیسی است. در اینجا $\bar{\bar{\epsilon}}_{eff}$ به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\bar{\bar{\epsilon}}_{eff} = \epsilon \begin{pmatrix} \frac{\alpha^2 n^2 - m^2}{\alpha n^2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{ck_z m}{\omega \alpha n^2} & \frac{\alpha^2 n^2 - m^2}{\alpha n^2} \end{pmatrix}, \quad (۱)$$

که $\alpha = (1 - \beta^2) / (1 - n^2 \beta^2)$

و $n = \sqrt{\frac{\beta(1 - n^2 \beta^2)^{-1} (n^2 - 1)}{\beta = v/c}}$ است. بطور مشابه تانسور تراوایی مغناطیسی موثر $\bar{\bar{\mu}}_{eff}$ از جایگذاری ϵ با μ در رابطه بالا بدست

با استفاده از روابط (۶) و (۸) می‌توان نشان داد که عملگرهای نابودی $\hat{a}_{\pm x}(z, \omega)$ و $\hat{a}_{\pm y}(z, \omega)$ در روابط جابجایی زیر صدق می‌کنند

$$[\hat{a}_{\sigma\pm}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma'\pm}^\dagger(z', \omega')] = \delta(\omega - \omega') \delta(z - z') \delta_{\sigma\sigma'}, \quad (۹)$$

$$[\hat{a}_{\sigma\pm}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma'\pm}(z', \omega')] = 0,$$

که در آن $\sigma, \sigma' = x, y$ است.

۳- روابط ورودی - خروجی

در این بخش روش کوانتشن ارائه شده در بخش قبل را برای تیغه مغناطودی الکتریکی متحرکی با ضخامت l که در خلاء قرار دارد بکار می‌بریم. در اینجا عملگرهای نابودی $\hat{a}_{\sigma\pm}^{(1)}(z, \omega)$ ، $\hat{a}_{\sigma\pm}^{(2)}(z, \omega)$ و $\hat{a}_{\sigma\pm}^{(3)}(z, \omega)$ به ترتیب متناظر با مدهای تابشی در نواحی $-\infty \leq z \leq -l/2$ ، $-l/2 \leq z \leq l/2$ و $l/2 \leq z \leq +\infty$ هستند. فرض می‌کنیم که لبه‌های خارجی تیغه در $z_1 = -l/2$ و $z_2 = l/2$ است. با توجه به رابطه (۶) عملگرهای نابودی در مکان $l/2$ برحسب عملگرهای نابودی در مکان $-l/2$ به صورت زیر نوشته می‌شوند

$$\begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma+}^{(2)}(l/2, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma-}^{(2)}(l/2, \omega) \end{pmatrix} = R_\sigma \begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma+}^{(1)}(-l/2, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma-}^{(1)}(-l/2, \omega) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_{\sigma+}^{(1)} \\ d_{\sigma-}^{(1)} \end{pmatrix}, \quad (۱۰)$$

که R_σ بیانگر یک ماتریس قطری 2×2 است که درایه‌های آن برای قطبش‌های $\sigma = x$ و $\sigma = y$ به صورت $R_{\sigma,11} = 1/R_{\sigma,22} = e^{-\gamma_2 \omega l/c}$ تعریف می‌شوند. در اینجا عملگر $d_{\sigma\pm}^{(1)}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

$$d_{\sigma\pm}^{(1)} = e^{\mp \gamma_2 \omega l/2c} \int_{-l/2}^{l/2} dz' D_{\sigma\pm}^{(j)}(z', \omega) e^{\pm \gamma_2 \omega z'/c} \quad (۱۱)$$

و $D_{x\pm}(z, \omega) = \pm i \sqrt{\gamma \omega / ce} e^{\mp i \beta \omega z/c} \hat{f}_{ex}(z, \omega)$ که

$$D_{y\pm}(z, \omega) = \frac{\pm i \sqrt{\gamma \omega / c} (\sqrt{E} \hat{f}_{e\pm}(\pm z', \omega) \pm in \sqrt{-\kappa'_{eff\ xx}} \hat{f}_{m\pm}(\pm z', \omega))}{\sqrt{|E| - |n|^2} \kappa'_{eff\ xx}}$$

است. با اعمال شرایط مرزی روی مولفه‌های مماسی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی، عملگرهای نابودی $\hat{a}_{\sigma\pm}^{(j+1)}(z_j, \omega)$ بر حسب عملگرهای نابودی $\hat{a}_{\sigma\pm}^{(j)}(z_j, \omega)$ می‌نویسیم. مولفه‌های میدان الکتریکی و

$$\begin{aligned} \hat{A}_x(z, \omega) &= \sqrt{\frac{\hbar \xi}{4\pi \epsilon_0 c \omega S}} \frac{\mu_{eff\ yy}}{n} \{ [e^{i\beta \omega z/c} \hat{a}_{x+}(z, \omega) \\ &+ e^{-i\beta \omega z/c} \hat{a}_{x-}(z, \omega) + h.c.], \end{aligned} \quad (۵)$$

$$\begin{aligned} \hat{A}_y(z, \omega) &= \sqrt{\frac{\hbar \xi'}{4\pi \epsilon_0 c \omega S}} \frac{\mu_{eff\ xx}}{n} \{ [e^{i\beta \omega z/c} \hat{a}_{y+}(z, \omega) \\ &+ e^{-i\beta \omega z/c} \hat{a}_{y-}(z, \omega) + h.c.], \end{aligned}$$

که $\hat{a}_{\pm x}(z, \omega)$ و $\hat{a}_{\pm y}(z, \omega)$ به ترتیب عملگرهای نابودی متناظر با مدهایی هستند که در راستای x و y قطبیده شده‌اند و برحسب عملگرهای بوزونی سامانه مزبور به صورت زیر تعریف می‌شوند

$$\begin{aligned} \hat{a}_{x\pm}(z, \omega) &= i \sqrt{2\gamma \omega / c} e^{\mp \gamma_2 \omega z/c} \int_{-\infty}^{\pm z} dz' e^{-in z' \omega / c} \\ &\times \hat{f}_{ex}(\pm z', \omega) \\ \hat{a}_{y\pm}(z, \omega) &= i \sqrt{2\gamma \omega / ce} e^{\mp \gamma_2 \omega z/c} \int_{-\infty}^{\pm z} dz' e^{-in z' \omega / c} \\ &\times \frac{\sqrt{E} \hat{f}_{e\pm}(\pm z', \omega) \pm in \sqrt{-\kappa'_{eff\ xx}} \hat{f}_{m\pm}(\pm z', \omega)}{\sqrt{|E| - |n|^2} \kappa'_{eff\ xx}}. \end{aligned} \quad (۶)$$

در این جا β و γ به ترتیب متناظر با قسمت حقیقی و موهومی ضرایب شکست n هستند. پارامترهای $\xi(\omega)$ و $\xi'(\omega)$ برحسب پارامترهای اپتیکی سامانه به صورت

$$\xi(\omega) = \frac{\mathcal{E}'_{eff\ xx}}{2\gamma} \quad \text{و} \quad \xi'(\omega) = \frac{|E| - |n|^2 \kappa'_{eff\ xx}}{2\gamma}$$

تعریف می‌شوند. به علاوه، عملگر بوزونی جدید $\hat{f}_{e\pm}(z, \omega)$ به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\hat{f}_{e\pm}(z, \omega) = \frac{mn(-e_{32} \hat{f}_{ey}(z, \omega) - e_{33} \hat{f}_{ez}(z, \omega))}{\epsilon \alpha \mu_{eff\ xx} \sqrt{E}} \quad (۷)$$

که $E = \left| \frac{mn}{\epsilon \alpha \mu_{eff\ xx}} \right|^2 (|e_{32}|^2 + |e_{33}|^2)$ است. به

سادگی می‌توان نشان داد که عملگر بوزونی جدید در روابط جابجایی زیر صدق می‌کند

$$[\hat{f}_{\lambda\perp}(z, \omega), \hat{f}_{\lambda'\perp}^\dagger(z', \omega')] = \delta(z - z') \delta(\omega - \omega') \delta_{\lambda\lambda'}, \quad (۸)$$

$$[\hat{f}_{\lambda\perp}(z, \omega), \hat{f}_{\lambda'\perp}(z', \omega')] = 0,$$

که $\lambda = \lambda' = e, m$ است.

می توان نشان داد که عملگرهای مدهای ورودی و خروجی در روابط جابجایی زیر صدق می کنند

$$\begin{aligned} & (16) \\ & [\hat{a}_{\sigma-}^{(1)}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma-}^{(1)\dagger}(z', \omega')] = [\hat{a}_{\sigma+}^{(3)}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma+}^{(3)\dagger}(z', \omega')] \\ & = \delta(\omega - \omega') \delta(z - z') \delta_{\sigma\sigma'}, \\ & [\hat{a}_{\sigma-}^{(1)}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma+}^{(3)\dagger}(z', \omega')] = [\hat{a}_{\sigma+}^{(3)}(z, \omega), \hat{a}_{\sigma-}^{(1)\dagger}(z', \omega')] \\ & = 0. \end{aligned}$$

روابط ورودی-خروجی (16) در حالت حدی محیط همسانگرد ساکن و یا محیط ناهمسانگرد ساکن با درایه های $\epsilon_{yz} = \mu_{yz} = 0$ در تطابق کامل با نتایج بدست آمده در مراجع [10-12] است.

۴- نتیجه گیری

در این مقاله با به کار بردن رهیافت پدیده شناختی، امواج الکترومغناطیسی در حضور محیطهای مغناطودی الکتریک متحرک نامتناهی کوانتیده شد. به عنوان هدف اصلی در بررسی اثرات پراکندگی تیغه متحرک بر حالت های کوانتومی فرودی، روابط کوانتومی ورودی - خروجی برای وضعیت خاصی که تیغه ی مغناطودی الکتریک عمود بر تابش های فرودی و به موازات سطح بیرونی اش حرکت می کند بدست آمد.

سپاسگزاری

نویسندگان، از معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد برای حمایت های انجام شده قدردانی می نمایند.

مراجع

- [1] H. Minkowski, *Nachr. Ges. Wiss. Gotingen* **1**, (1908) 53.
- [2] W. Pauli, *Theory of Relativity* (Pergamon, New York, 1958).
- [3] A. Sommerfeld, *Optik*, 2nd ed. (Akademische, Leipzig, 1959).
- [4] T. K. Shiozawa, K. Hazawa, and N. Kumagai, *J. Appl. Phys.* **38**, (1967) 4459.
- [5] T. M. Grzegorzcyk and Jin. Au. Kong, *Phys. Rev. B* **74**, (2006) 033102.
- [6] U. Leonhardt, and P. Piwnicki, *Phys. Rev. Lett.* **84**, (2000) 822.
- [7] R. Matloob, *Phys. Rev. A* **71**, (2005) 062105.
- [8] S. A. R. Horsly, *Phys. Rev. A* **86**, (2012) 063822.
- [9] H. T. Chen, *Theory of Electromagnetic Waves* (McGraw-Hill, New York, 1983).
- [10] R. Matloob and G. Pooseh, *Optics. Communications.* **181**, (2000) 109.
- [11] Y. Dong and X. Zhang, *J. Opt.* **13** (2011) 03540.

[12] ۱. عموقربان، ع. مهدی فر و م. حسین زاده " روابط کوانتومی ورودی- خروجی برای متامواد مغناطودی الکتریک چندلایه ای جاذب و ناهمسانگرد"، مجله پژوهشی فیزیک ایران، به زودی منتشر می شود.

میدان مغناطیسی به ترتیب از مشتق زمانی و تاو روابط (5) بدست می آید. بنابراین داریم

$$\begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma+}^{(j+1)}(z_j, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma-}^{(j+1)}(z_j, \omega) \end{pmatrix} = S_{\sigma}^{(j)} \begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma+}^{(j)}(z_j, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma-}^{(j)}(z_j, \omega) \end{pmatrix}. \quad (12)$$

که $j = 1, 2$ است. اکنون با ترکیب روابط (10) و (12) مرتب کردن رابطه مزبور به گونه ای که عملگرهای نابودی متناظر با مدهای خروجی برحسب عملگرهای نابودی مدهای ورودی بیان شوند، رابطه ی کوانتومی ورودی - خروجی را برای تیغه مغناطودی الکتریک متحرک بدست می آوریم. این رابطه به صورت زیر نوشته می شود

$$\begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma-}^{(1)}(-l/2, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma+}^{(3)}(l/2, \omega) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{\sigma} & T_{\sigma} \\ T_{\sigma} & R_{\sigma} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_{\sigma+}^{(1)}(-l/2, \omega) \\ \hat{a}_{\sigma-}^{(3)}(l/2, \omega) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{F}_{\sigma-}^{(1)}(\omega) \\ \hat{F}_{\sigma+}^{(1)}(\omega) \end{pmatrix}. \quad (13)$$

در اینجا $\hat{F}_{\sigma\pm}^{(1)}(\omega)$ بیانگر ویژگی های اتلافی تیغه است و ماتریس جذب محیط نامیده می شود. به دلیل کمبود فضا از ذکر جزئیات رابطه مزبور خودداری می کنیم. ضرایب R_{σ} و T_{σ} اثرات عبور و بازتاب مدهای فرودی بر تیغه ی مغناطودی الکتریک متحرک را بیان می کنند و به صورت زیر نوشته می شوند

$$\begin{aligned} R_{\sigma} &= \frac{(e^{2im_2\omega/c} - 1)(n_2^2 - \xi_{\sigma}^2) e^{-i\omega l/c}}{(\xi_{\sigma} + n_2)^2 - (\xi_{\sigma} - n_2)^2 e^{2im_2\omega/c}}, \\ T_{\sigma} &= \frac{4n_2\xi_{\sigma} e^{-i\omega l/c} e^{im_2\omega l/c}}{(\xi_{\sigma} + n_2)^2 - (\xi_{\sigma} - n_2)^2 e^{2im_2\omega/c}}. \end{aligned} \quad (14)$$

پارامتر ξ_{σ} برای قطبش های x و y به ترتیب برابر با $\mu_{eff\ xx,2}$ و $\mu_{eff\ yy,2}$ است. مقدار چشم داشتی عملگرهای نوفه بر حسب ضرایب بازتاب و عبور به صورت زیر نوشته می شوند

$$\langle F | \hat{F}_{\sigma\pm}^{\dagger}(\omega) | F \rangle = \langle F | \hat{F}_{\sigma\pm} | F \rangle = 0, \quad (15)$$

$\langle F | \hat{F}_{\sigma\pm}^{\dagger}(\omega) \hat{F}_{\sigma\pm}(\omega') | F \rangle = n(\omega, T) (1 - |R_{\sigma}|^2 - |T_{\sigma}|^2) \delta(\omega - \omega')$ که در آن $n(\omega, T) = [\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1]^{-1}$ بیانگر میانگین تعداد فوتون های گرمایی است. به سادگی